

令和8年4月3日

委員各位

公益社団法人応用物理学会  
半導体の結晶成長と加工および評価に関する産学連携委員会  
委員長 小椋厚志

半導体の結晶成長と加工および評価に関する産学連携委員会  
第14回研究会 開催通知

近年の急速な AI(人工知能)技術の発展に伴い、より高速、低消費電力なメモリの開発が喫緊の課題となっています。これを実現するバックエンド・オブ・ライン(BEOL)材料として、酸化物半導体への注目が急拡大しています。今回、下記のように、BEOL デバイスにフォーカスした酸化物半導体の材料・デバイス技術に関する研究会を開催いたします。多数ご参加下さいますようお願い申し上げます。

記

日時:2026年6月30日(火)13:00-16:50

会場:明治大学駿河台キャンパス グローバルフロント1階 グローバルホール

[https://www.meiji.ac.jp/koho/campus\\_guide/suruga/access.html](https://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html)

テーマ:「酸化物半導体を用いたバックエンド・オブ・ライン(BEOL)デバイス応用の進展」

世話人:森田行則(産総研)、横川凌(広大)

プログラム

13:00~13:05	開会の挨拶	明治大学 小椋厚志
13:05~13:10	はじめに	産総研 森田行則
13:10~14:10	「酸化物半導体 GAAFET(仮)」	東京大学 小林正治
14:10~14:55	「Oxide-semiconductor Channel Transistor DRAM (OCTRAM) for High-density and Low-power AI memory(仮)」	キオクシア 株柳翔一
14:55~15:15	休憩	
15:15~16:00	「InOx MOSFET process and characteristics(仮)」	産総研 Chen Chia-Tsong
16:00~16:45	「P型酸化物半導体開発動向(仮)」	TEL 吉松孝宗
16:45~16:50	おわりに	広島大学 横川凌

17:20~19:40 意見交換会(明治大学 駿河台キャンパス グローバルラウンジ)

以上